

平成 17 年度応用物理学会九州支部学術講演会:特別シンポジウム
日時:平成 17 年 11 月 26 日(土)、場所:福岡工業大学工学部

< プ ロ グ ラ ム >

1. 挨拶 (14:00~14:05)

九州大学産学連携センター・教授 中 島 寛 氏

2. 基調講演(14:05~14:55; 40 分講演、10 分質疑応答)

題 目 「日本の半導体産業と R&D」

講 師 (株)ルネサステクノロジ・業務執行役員 西 村 正 氏

3. シンポジウム

招待講演(14:55~15:30; 30 分講演、5分質疑応答)

題 目 「酸化濃縮法による SGOI 基板の作製と、高移動度 CMOS への適用」

講 師 MIRAI-ASET 手 塚 勉 氏

休 憩 (15:30~15:45)

座長:九州大学大学院システム情報科学研究院・助教授 佐道 泰造 氏

1. 高品質歪 Si-SGOI ウェーハ (15:45~16:10)
(株)SUMCO・技監 中前 正彦 氏
2. 歪 Si-SGOI 用 SiGe バッファ層の極薄化 (16:10~16:35)
九州大学大学院システム情報科学研究院・教授 宮尾 正信 氏
3. 半導体分析評価技術と歪 Si ウェーハへの応用 (16:35~17:00)
福菱セミコンエンジニアリング (株) 副センター長・榎田 豊次 氏
4. 歪 Si-SGOI ウェーハの欠陥評価 (17:00~17:25)
九州大学産学連携センター・教授 中 島 寛 氏
5. 歪 Si-SGOI のデバイス試作 (17:25~17:50)
九州工業大学マイクロ化総合技術センター・教授 浅野 種正 氏